

Das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) im Forschungsverbund Berlin e.V. ist ein international führendes Forschungsinstitut auf den Gebieten der Diodenlaser, LEDs und der Mikrowellenbauelemente. Auf der Basis von III/V Halbleitern erforscht und realisiert es Komponenten und Systeme u.a. für Anwendungen in Kommunikation, Verkehrs- und Produktionstechnik, Medizin und Biotechnologie. Es verfügt über die gesamte Wertschöpfungskette vom Design bis zu lieferfertigen Systemen. Weiteres unter: www.fbh-berlin.de

Für das InP Devices Lab, das sich mit der Herstellung von auf Indiumphosphid basierten Halbleiter-Höchstfrequenzschaltkreisen beschäftigt, suchen wir zwei

Technische Mitarbeiter/-innen:

Halbleiter-Beschichtung/-Strukturierung

Kennziffer 02/18

Im Rahmen der am FBH etablierten InP-Heterobipolar-Schaltkreistechnologie für THz-Anwendungen sind Sie für die Prozessierung von Pilotlinien-Waferlosen mit unseren modernen Anlagen sowie die Qualitätssicherung durch automatisierte Messverfahren verantwortlich. Die Schwerpunkte Ihrer Arbeit liegen bei der Halbleiter-Beschichtung in der Dünnschicht-Metallisierung mittels Bedampfer- und Sputterverfahren, der Mikrogalvanik sowie der Plasmabeschichtung bzw. bei der Halbleiter-Strukturierung in der nasschemischen und plasmatechnischen Strukturierung von Halbleiterwafern.

Sie arbeiten dabei mit bestehenden Prozessen und wirken außerdem bei deren Optimierung mit. Ihre Aufgaben beinhalten u.a. die

- Durchführung und Überwachung von Prozessschritten an automatisierter und manueller Anlagentechnik zur Mikrostrukturierung von Halbleiterwafern,
- Kontrolle und Bewertung der Arbeitsergebnisse, meist mittels Mikroskopie,
- Anwendung automatisierter Messverfahren,
- Qualitätssicherung: Dokumentation der Prozessschritte und Anlagenparameter,
- Überwachung und Absicherung des Anlagenzustandes sowie Übernahme der technischen Verantwortung für einzelne Anlagen.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Mikrotechnologin/Mikrotechnologe, Physik-/Chemielaborant/-in oder staatlich geprüfte Technikerin/geprüfter Techniker im Bereich der Elektrotechnik mit Bezug zur Halbleitertechnologie. Sie sollten über fundiertes Fachwissen zur Technologie von Halbleiterbauelementen, manuelles Geschick sowie technisches Verständnis auf dem Gebiet der Labor- und Anlagentechnik verfügen. Erfahrungen und Kenntnisse in der Plasma-Ätztechnik, zu Bedampfungs-, Sputter- oder Plasmabeschichtungsverfahren für dünne Schichten, Mikrogalvanik und/oder Elektronenstrahlmikroskopie sind wünschenswert.

Wir bieten eine anspruchsvolle interdisziplinäre Tätigkeit bei der Entwicklung von neuartigen Halbleiterbauelementen. Wir erwarten selbständiges Arbeiten, Verlässlichkeit, Teamgeist und gute Englischkenntnisse.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD (Bund). Die Stellen können **sofort** besetzt werden und sind zunächst auf 2 Jahre befristet. Vorausgesetzt wird die Eignung zur Arbeit in Reinräumen sowie die Bereitschaft zur Schichtarbeit im Zweischichtsystem von Montag bis Freitag. Für weibliche und männliche Bewerber besteht Chancengleichheit. Qualifizierte Frauen werden daher besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum **23.02.2018** unter Angabe der entsprechenden Kennziffer an das:

Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
Frau N. Möller (nadine.moeller@fbh-berlin.de)
Gustav-Kirchhoff-Straße 4, 12489 Berlin